文章编号:1006-9941(2013)04-0500-06

短脉冲电流作用下铜微桥箔的电热分析

王 亮, 邹苑楠, 蒋小华, 只永发

(中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621900)

乔箔是高能^{~~} 摘 要:等离子体换能起爆技术是一种具有高安全性和高可靠性的先进起爆技术,微桥箔是高能等离子体换能元的重要组成部 分。本研究采用有限元方法对短脉冲电流作用下铜微桥的电热过程进行了模拟,模拟结果表明在桥区的四个拐点处升温速率最 高,热量从这四个区域向整个桥区扩散;在同一脉冲刺激下,桥区尺寸越小,达到融化温度所需时间越短。当输入脉冲电流周期不 变时,随着充电电压的降低,桥区中心处温度达到融化温度所需的时间逐渐增加,当电压降低至一定值后(临界电压),桥区将不能 完全融化;在临界电压附近,达到融化温度所需的时间随电压变化的趋势越明显。

关键词:材料物理与化学;微桥箔;电热分析;有限元;电爆炸 中图分类号: TJ450.1 文献标识码:A

DOI: 10.3969/j.issn.1006-9941.2013.04.019

1 引 言

等离子体起爆技术是一种具有高安全和高可靠性 的先进起爆技术,受到国内外广泛重视,其中微桥箔是 高能等离子体换能元的重要组成部分,起到能量转换 的作用,其吸收起爆回路输出的脉冲能量,发生金属电 爆炸,电爆炸产生等离子体快速膨胀为后续推动飞片 提供动力源^[1-2]。因此,研究微桥箔的电爆炸作用过 程具有重要意义。

金属电爆炸过程的机制非常复杂,包括两个基本 机理:与焦耳热有关的热机理和为磁流体动力学不稳 定性发展所决定的"力学"机理^[3]。国外研究较早,得 到了一些相对成熟的理论模型。1977 年 Logan 等[4] 报道了他们对电爆炸箔加热和爆炸现象的试验与计算 研究结果,计算使用了有限差分算法。Stanton 报道了 用于计算爆炸箔特性的一维流体动力学计算编码 CHARTD。1987 年,美国 Los Alamos^[5] 实验室利用 一维磁流体动力学程序 CONFUSE 对金属箔电爆炸过 程进行了数值模拟。现在国外已经发展到用二维结合 三维磁流体动力学模型对金属箔电爆炸过程进行模 拟^[6],可以获得电压、电流、电阻等参数。国内对金属 电爆炸模型的研究处于起步探索阶段,大部分工作还 是利用外部仪器设备来检测所发生的现象^[7-8]。胡晓

收稿日期: 2012-09-08; 修回日期: 2012-02-27 作者简介: 王亮(1984 -),男,硕士研究生,主要从事新型火工品的设 计与研究。e-mail: I_wang_caep@ yahoo.com

棉^[9]、韩成智^[10]等建立了桥箔电爆炸过程的二维模 型,但是模型中电阻率的方程采用了简化模型,所以还 是一种半经验的模型。虽然国外已经研发出了爆炸箔 二维和三维的动力学模型,能通过公式获得其动态参 数,但很少从理论上研究电爆炸过程中的温度变化和 分布情况。而在电爆炸过程中桥箔的温度是表征电爆 炸特性的重要参数,其升温过程可反映桥箔电爆炸动 态变化过程,因此,有必要对爆炸箔电爆炸过程的温度 分布情况进行研究。导体固体加热阶段为爆炸箔电爆 炸的第一个阶段,它对形成等离子体的浓度和时间有 着重要的影响,而等离子体是后续推动飞片的动力源, 直接影响起爆电流。因此,爆炸箔在加热阶段的电热 分析具有重要意义,为理论研究电爆炸过程中的温度 变化和分布提供基础。本研究利用有限元方法对铜微 桥箔融化前的电热过程进行了分析,同时讨论了输入 电流参数对电热过程的影响,对桥箔与脉冲参数的合 理匹配具有一定作用。

2 电热方程的无量纲化

铜微桥箔在脉冲电流输入下由于焦耳热作用温度 升高,在桥区融化前,是电热耦合作用。其热作用可用 瞬态热传导方程(1)表示^[11],

$$c_{v}\rho_{m}\frac{\partial T}{\partial t} = \sigma_{e}|E|^{2} + \nabla \cdot (k\nabla T)$$
⁽¹⁾

式中, c_v 为比热, J·kg⁻¹·K⁻¹; ρ_m 为桥箔密度, $kg \cdot m^{-3}$; T 为温度, K; t 为时间, s; σ_{o} 为电导率,

S·m⁻¹; *E* 为电场强度, V·m⁻¹; *k* 为热导率, $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ 。铜的比热 c_v 和热导率 k 是温度的函 数,其与温度(T < 1500 K)关系用公式(2)和(3)表 示[11]. $c_v = 0.1004 T + 355.12$ (2) k = -0.0685T + 420.75(3) 而铜的电阻率 ρ_{o} 与温度的关系为^[12]: $\rho_{a} = -4.12 \times 10^{-10} + 0.113 \times 10^{-5} (T/11604)^{1.145}$ (4) 同时,该过程满足电荷在导体中传输的连续方 程^[13]: (5) $\nabla \cdot J = E \cdot \nabla \sigma_e + \sigma_e \nabla E = 0$ 式中, J为电流密度, A·m⁻²。通过求解上述两个方 程可对微桥箔在脉冲电流刺激下的电热效应进行分 析。将方程组进行无量纲化处理,令: $t^* = t/t_n$ (6)

$$l^* = l/w \tag{7}$$

$$T^* = (T - T_{amb}) / (T_m - T_{amb})$$
(8)

$$I^* = I/I_{\max} \tag{9}$$

$$m^* = m / \left[\frac{I_{\text{max}}^2 t_{\text{cycle}}^3}{\sigma_{\text{e}} (T_{\text{amb}}) w^3} \right]$$
(10)

式中, t_p 为输入电流脉冲的周期,s; l 为桥区长度,m; w 为桥区宽度,m; T_m 为桥箔融化温度,K; T_{amb} 为环 境温度,K; l 为电流,A; I_{max} 为输入电流峰值,A; t_{cycle} 为脉冲电流周期,s; 上标带 * 的变量为无量纲量。将 其带入控制方程中,有:

$$\nabla^{*} = \left(\frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}i + \frac{\partial}{\partial x}k\right) / \left(\frac{1}{w}\right)$$
(11)

$$c_{v}^{*} = c_{v} / \left[\frac{W^{2}}{(T_{m} - T_{amb}) t_{cycle}^{2}} \right]$$
(12)

$$\rho_{\rm m}^{*} = \rho_{\rm m} / \left[\frac{I_{\rm max}^{2} t_{\rm cycle}^{\prime}}{\sigma_{\rm e}^{\prime} (T_{\rm amb}) w^{6}} \right]$$
(13)
$$\sigma_{\rm e}^{*} = \sigma_{\rm e} / \sigma_{\rm e}^{\prime} (T_{\rm amb})$$
(14)

$$E^* = E / \left[\frac{I_{\text{max}}^2 t_{\text{cycle}}^3}{\sigma_{\text{e}} (T_{\text{amb}}) w^2} \right]$$
(15)

$$k^{*} = k / \left[\frac{I_{\text{max}}^{2}}{(T_{\text{m}} - T_{\text{amb}}) \sigma_{\text{e}}(T_{\text{amb}}) w^{2}} \right]$$
(16)

式中,x,y,z分别为笛卡尔坐标系的 x 轴, y 轴, z 轴; *i*,*j*,*k*分别为 x 轴, y 轴, z 轴的单位矢量。

3 电热过程的有限元模型

3.1 桥箔物理结构与基本假设

采用有限元分析软件 Ansys/Multiphysics 对铜微

桥箔融化前的电热过程进行模拟。为减少计算量, 假 设桥箔在厚度方向上材质均匀,则可将问题简化为二 维的。由于桥箔为对称结构,取桥箔的上半部分进行 分析,图1所示为微桥箔建模及网格划分示意图, 微桥 箔的桥区长度和宽度分别 *l* 和 *w*, *R*₁ 和 *R*₂ 分别为 0.01 mm和 0.5 mm, 桥区与连接区的夹角为 45°, 桥 箔总长度和总宽度为 9.4 mm 和 5 mm。



图1 微桥箔网格划分及边界条件示意图

Fig. 1 Finite element mesh and boundary conditions of a small scale bridge foil

3.2 边界与初始条件

由于铜的热导率与电导率相比存在量级上的差距,因此,可忽略桥箔与环境的热传导,即桥箔边界上 有▽*T*=0,具体的边界条件见图1所示。初始时刻 桥区温度为环境温度。桥箔的输入电流I由一个容量 C为0.025 μF的电容放电单元施加,该电容放电单元 在 800 V 充电电压条件下的试验所得短路电流波形 如图 2 所示。





Fig. 2 Comparison between the current waveform recorded using current probe and calculated one

一般地,电容放电回路可视为一个串联 RLC 电路, 根据短路试验结果可以推算回路电感 *D* 和电阻 *R*^[14]。 RLC 回路的电流可通过公式(17)计算得到^[15-16]:

$$I(t) = V \left[L \sqrt{\frac{1}{L \cdot C} - \frac{R_c^2}{4L^2}} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{L \cdot C} - \frac{R_c^2}{4L^2}t}\right) e^{-\frac{R_c}{2L}t} \right] (17)$$

根据方程(17)计算得到短路电流曲线与试验曲线 在第一个半周期内基本一致(图2),而对于爆炸箔的电 热过程以及电爆炸通常只有第一个半周期有效,因此电 流输入条件可通过方程(17)从理论上获得。由于将微 桥箔负载连入回路后,回路电阻为 $R_c(t) = R + R_{foil}(t)$, 其中, R_{foil} 为微桥箔电阻,是时间 t 的函数,相应地,方 程(17)中的电阻应为含负载的回路电阻。另外,对于 二维电热问题, Ansys 默认微桥箔为单位厚度,因此, 输入 Ansys 的电流应乘以一个系数 w/ t_{foil} 。

4 论微桥箔电热过程分析与讨论

4.1 脉冲电流刺激下微桥箔桥区温度变化过程

对桥区尺寸为100 m×100 m×2 m的铜微桥在图 2 所示的脉冲电流作用下的电热过程进行了模拟,桥箔 初始电阻约为40 mΩ。图 3 所示为不同时刻微桥箔桥 区的温度分布情况及铜桥箔电爆炸后桥区显微图。



图 3 不同时刻微桥箔桥区的温度分布情况及铜桥箔电爆炸 后桥区显微图

Fig. 3 Temperature distribution of the small-scale bridge foil at different time steps

从图 3 可以看出,在 t* =0.1 时,桥区的四个拐点 处最早在输入电流的作用下开始升温,但升温并不明 显,此时,微桥箔其它区域无明显升温现象。随后,随 着输入电流的快速增大,整个桥区范围内的温度由于 焦耳热作用迅速升高,而桥区四个拐点处由于温度高 于桥区中心区域,其电导率随之有一定幅度降低,电阻 较之其它区域高,因此,该处的升温速率进一步增大; 同时,由于热传导作用,最早产生温升的桥区边缘温度

也向中心扩散,最终在 t^* = 0.19 的时候,整个桥区基 本完全达到融点。随着电流的持续输入,桥区将有可 能发生融化、气化、甚至等离子体化。图 3f 是铜桥箔 等离子体化后的显微图,可以看出发生爆炸的桥区的 形状与模拟桥区的温度梯度基本一致,因此,推测可通 过桥区融化前的温度变化研究对桥箔的爆发情况进行 预估。另外,若要实现桥区的电爆炸且能量利用率最 高,则需要实现桥箔形状和尺寸与输入电流的匹配,最 优化的匹配是桥区正好在电流达到峰值时发生电爆 炸,而对于桥区尺寸为数百微米的爆炸箔,经验表明桥 区融化时间约为爆发时间的90%^[17-18],因此,可以通 过计算桥区融化所需时间实现桥区参数与输入电流的 匹配。通过微桥箔在短脉冲电流作用下的电热分析仅 能对电爆炸的过程进行推测,对爆炸箔的指导作用有 限,然而,金属电热作用是电爆炸过程的第一步,在电 热分析基础上,结合桥箔的融化热,金属电爆炸等离子 体的状态方程将能够从理论上实现具有物理意义的电 爆炸完整过程的三维模拟,真实的指导爆炸箔的设计。 目前,获得准确的等离子体状态方程存在一定难度,然 而,随着等离子体流场参数的测试方法日趋精确和多 样,如多通道光学高温计^[19],粒子图像测速方法^[20]、 纹影高速摄影技术[21]等,能够促使进一步了解和认识 电爆炸产生等离子体的本质,并最终实现电爆炸过程 的预测。

对桥区四个区域的电流密度随时间变化情况进行 了分析,如图 4 所示。区域 1 对应于桥区中心,区域 4 对应于桥区拐点处。



图 4 桥区各处电流密度 *J**随时间变化的曲线 Fig. 4 The variation of current density *J** with time at different locations

从图 4 可以看出,拐点处的电流密度明显大于其 它几个区域,中心处的电流密度稍大于 2、3 点处的电

流密度,而2、3点处的电流密度相差不大。一般地, 电子在金属中的运动分为热运动与自由运动,当在铜 微桥箔两端施加电压时,每个自由电子都将受到电场 力的作用,使电子沿着与场强相反的方向相对于晶格 做加速的定向运动。由于整个桥箔范围内电子的热运 动矢量平均为零,因此,桥区内的电流密度分布主要与 自由电子在电场中的运动相关。电子的漂移速度通常 约为 10^{-4} m · s⁻¹, 而此处微桥箔的融化时间不足 100 ns,因此,电子的运动距离很短,而拐点处由于截 面积陡然缩小,导致了拐点处电子聚集,电子数密度较。 之其它区域非常大,根据J=nev(n为电子数密度, m⁻²; e 为电子所带电荷, C; v 为漂移速度, m · s⁻¹) 可以判断拐点处的电流密度最大。由于拐点处电子数 密度大,该处自由电子与晶体点阵上的原子实碰撞的 频率更高,在碰撞时把定向运动能传递给原子实,使之 热运动加剧,使得该处的温度快速升高,因此,该处的 产生温升最高,并目升温速率也最快,如图5所示。



图 5 桥区各处温度 T^{*}随时间变化的曲线 Fig.5 The variation of temperature T^{*} with time at different locations

从图 5 可以看出,中心处的升温速率及温度较之 2,3 处的稍高,这表明热扩散是桥区产生温度梯度的 主要原因,并且,热量最初从桥区四个拐点处以圆弧 *R*₁ 圆心为原点,从半径为*R*₁ 的圆弧开始向四周扩散, 因此,可以推断该圆弧的半径对于桥箔的设计是非常 重要的。尽管桥区中心处与圆弧*R*₁ 的距离较之 2,3 点稍大,但由于两个圆弧的热量甚至四个圆弧的热量 均可扩散至桥区中心处,而 2,3 点因热扩散升温则主 要依靠与之接近的一个圆弧,这也是为何 3 处的温度 和升温速率高于 2 处,因此,可以推断在桥箔设计中, 桥区的长度也是一个需要重点考虑的参数。

4.2 输入电流对微桥箔电热过程的影响

此外,探讨了充电电压对桥区升温速率的影响。

一般地,同一电容放电回路的回路电感和电阻不变,即 输出电流波形周期长短不随充电电压变化而改变,而 对于不同充电电压条件下的输出电流波形,其无量纲 化的电流-时间曲线均是一致的,如图6中计算无量纲 电流曲线1*所示。对不同电压输入条件下桥箔的电 热过程进行了模拟,图6所示为不同输入电压条件下 微桥箔桥区中心处的温度随时间的变化曲线。



图 6 不同电压条件下桥区中心的温度变化曲线 Fig. 6 Nodal temperature profiles at the center of small-scale bridge foils under specified input voltages

从图 6 可以看出,在其它条件不变的情况下,随着 电压的升高,桥区中心处温度达到融化温度所需的时间 逐渐缩短,因此,在进行桥箔能量利用率优化时,充电电 压与桥箔之间也存在一定的匹配关系,而不仅仅是放电 回路的周期。当电压小于一定值时,放电回路输出的脉 冲电流将无法使桥区中心达到融化温度,对于本研究的 算例,当充电电压为 395 V时,桥区中心温度在半个周 期内无法达到桥箔的融点,而当电压降至 300V时,无 量纲温度 T^{*}最大只能达到 0.4,其升温速率明显低于 400 V时的升温速率,升温速率的急剧降低主要是由 于电流较小,前半周期电流上升部分桥箔温度升高缓 慢,进而导致电阻增大幅度较之电压为 400 V时较 小,由此产生的焦耳热变少,因此,升温缓慢。

研究了充电电压对桥区中心处升温至融点($T^* = 1$) 所需的时间的影响,计算结果如图 7 所示。从图 7 可 以看出,能够使桥区达到融化温度的临界充电电压约 为 400 V。输入电压低于临界充电电压时,桥区不能 完全达到融化温度;当充电电压略大于临界电压时, t_{melt} *随电压增大而较大幅度地缩短,而当电压达到 800 V时, t_{melt} *变小的趋势不明显。

4.3 微桥箔电热过程与桥区尺寸的关系

采用容量为0.025 μF 的电容放电单元对三种宽

含能材料

度的铜微桥箔进行了爆发电流电压测试,充电电压为 800 V,桥区尺寸分别为: 20 μ m × 20 μ m × 2 μ m、 40 μ m × 40 μ m × 2 μ m、60 μ m × 60 μ m × 2 μ m。 图 8为测试得到的桥箔电爆炸过程的流过桥区的电流 和桥区两端电压随时间变化的曲线。



图 7 桥区中心升温至融点所需时间 t_{melt}*与充电电压的关系 **Fig.7** Relationship between time for the center node of the bridge to reach the melt point and input voltages





Fig. 8 The current and voltage profiles of exploding foils that have different bridge width

根据试验条件,对微桥箔的中心点温度变化情况 进行了模拟,进而获得不同宽度同微桥箔达到融化温 度所需的时间,结果如图9所示。

通过电流电压曲线可以确定微桥箔的爆发时间, 与计算所得的微桥箔桥区中心融化所需时间 t_{melt}进行 了对比,见表1。从表1可以看出,融化所需时间占爆 发时间的比例随铜微桥箔的桥区宽度增大而变大,推 测当桥区宽度达到一定值后,达到融化温度所需时间 占比例将不再随宽度增加而发生较大变化,即对于数 百微米的爆炸箔,其融化时间占爆发时间的比例基本 是固定的,与国外学者的研究是吻合的^[17-18]。



图 9 不同宽度微桥箔桥区中心点的温度变化曲线 Fig. 9 Nodal temperature profiles at the center of small-scale bridge foils

表 1 不同桥区宽度微铜箔的融化所需时间与实测爆发时间对比 **Table 1** Comparison between calculated *t*_{melt} and burst time for micro copper foils

bridge width/ μ m	t _{melt} /ns	burst time/ns	percentage /%
20	15.7	51.2	30.7
40	25.0	62.4	40.1
60	33.9	68.8	49.3
100	49.6	-	-

5 结 论

采用有限元方法对脉冲电流刺激下铜微桥箔的电 热过程进行了分析,得到如下结论:

(1)在桥区的四个拐点处升温速率最高,热量从 这四个区域向桥区内部扩散。

(2)在输入脉冲电流周期不变的条件下,随着充电电压的升高,桥区中心处温度达到融化温度所需的时间逐渐缩短。

(3)存在一个使桥区达到融化的临界电压,当输入电压低于临界充电电压时,桥区不能完全达到融化 温度;当充电电压略大于临界电压时,*t*_{melt}*随电压增 大而较大幅度地缩短,而当电压远大于临界电压时, *t*_{melt}*变小的趋势不明显。

(4)融化所需时间占爆发时间的比例随铜微桥箔的桥区宽度增大而变大,当桥区宽度达到一定值后,达 到融化温度所需时间占比例基本不变。

参考文献:

 [1] 曾庆轩,袁士伟,罗承沐. 新型电爆炸箔系统电压对爆发电流影响 的实验研究[J].火工品,2002(1):41-42.
 ZENG Qing-xuan, YUAN Shi-wei, LUO Cheng-mu. Study to the effect of the voltage of a new type of exploding foil initiator system to firing current[J]. *Initiators & Pyrotechnics*, 2002(1): 41-42.

- [2] 成剑,栗保明. 电爆炸过程导体放电电阻的一种计算模型[J]. 南京理工大学学报,2003,27(4):371-375.
 CHENG Jian, LI Bao-ming. A theoretical model for wire resistance in wire exploding process[J]. *Journal of Nanjing University of Science and Technology*, 2003, 27(4):371-375.
- [3] 王莹. 电爆炸导体及其应用[J]. 爆炸与冲击,1986,6(2):184-192.

WANG Yin. The application of exploding conductor[J]. *Explosion and Shock Waves*, 1986, 6(2): 184–192.

- [4] Logan J D, Lee R S, Weingart R C. Calculation of heating and burst phenomena in electrically exploded foils [J]. J Appl Phys, 1977, 48(2): 621–628.
- [5] Lindemuth I R, Brownell J H, Greene A E. Exploding metallic foils for slapper, fuse and hot plasma applications: computational predictions, experimental observations [J]. *IEEE Pulsed Power*, 1987, 30:299 – 305.
- [6] Majalee A, Ikkurthi V R, Chaturvedi P S. Mixed 3-D/2-D simulation of an exploding foil opening switch[J]. *IEEE Pulsed Power*, 2003, 2:7803-7815.
- [7] 周翔.用于冲击片雷管的 Al/CuO 反应含能桥膜研究[D].南京:南京理工大学,2012.
 ZHOU Xiang. Research on Al/CuO-based reactive energetic bridge foils applied in exploding foil initiator [D]. Nanjing: Nanjing University of Science & Technology, 2012.
- [8] Rui Guo, Yan Hu, Ruiqi Shen, et al. A micro initiator realized by integrating KNO₃ @ CNTs nanoenergetic materials with a Cu microbridge[J]. Chemical Engineering Journal, 2012, 211: 31 -36.
- [9] 韩成智.电爆炸箔起爆系统作用过程研究[D].北京:北京理工 大学,2006.HAN Chen-zhi. Study on process of exploding foil initiation sys-

tem[D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2006.

 [10] 胡晓棉. 电爆炸箔起爆系统的设计优化、数值模拟及安全性[D]. 北京:北京理工大学,1998.
 HU Xiao-mian. Design, numerical simulation, and safety of exploding foil initiation system [D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 1998.

- [11] Frank P I, David P D. Fundamentals of Heat and Mass Transfer [M]. 4th edition, John Wiley & Sons, New York, 1996.
- $[\,12\,]$ Burgess T J. Electrical resistivity model of metals[C] // 4th International Conference on Megagauss Magnetic-Field generation and related Topic, Santa Fe, N. Mex, 1986
- [13] Tsang T. Classical Electrodynamics [M]. World Scientific, New Jersey, 1999.
- [14] 谭迎新,张景林,谭汝媚.飞片起爆试验装置中能源供给系统的性能[J].火炸药学报,2005,28(1):22-24.
 TAN Ying-xin, ZHANG Jing-lin, TAN Ru-mei. Properties of the supplying power system for the flyer-initiating device[J]. *Chinese Journal of Explosives & Propellants*, 2005, 28(1):22-24.
- [15] Resnick R, Halliday D. Physics [M]. Wiley International Edition, New York, 1966.
- [16] Dolan T J. Fusion Research: Principles, Experiments and Technology[M]. Pergamon Press, Oxford, 2000.
- [17] Baginski M E, Baginski T A, Thomas K. A comparison of the electrodynamics of metal under the action of large electric currents
 [J]. Inter J Applied Electromagnetics and Mechanics, 1996, 7: 193 202.
- [18] Baginski M E, Shaffer E C, Thomas K A. A comparison of the electrodynamics of metal under the action of large electric currents
 [J]. Inter J Applied Electromagnetics and Mechanics, 2000, 11: 79 – 93.
- [19] 伍俊英,冯长根,陈朗.金属电爆炸等离子体辐射温度测量[J]. 战术导弹技术,2006(5):31-33.
 WU Jun-ying, FENG Chang-gen, CHEN Lang. Plasma radiation temperature measurement of metal explosion[J]. *Tactical Missile Technology*, 2006(5):31-33.
- [20] Michael J M, Ronald J A. particle response to shockwaves in solids: dynamic witness plate/PIV method for detonations[J]. *Experiments in Fluids*, 2007, 43(2-3): 163-171.
- [21] 伍俊英,陈朗,王飞. 金属桥箔电爆炸等离子体流场实验研究
 [J]. 北京理工大学学报,2011,31(1):1-4.
 WU Jun-ying, CHEN Lang, WANG Fei. Experimental study of plasma evolution produced by metal bridge foil exploding[J]. *Transactions of Beijing Institute of Technology*, 2011, 31(1):1-4.

Thermal-electric Analysis of Small-scale Copper Bridge Foils Excited by Short Pulse Currents

WANG Liang, ZHOU Yuan-nan, JIANG Xiao-hua, ZHI Yong-fa

(Institute of Chemical Materials, CAEP, Mianyang 621900, China)

Abstract: Plasma initiation is an advanced initiating technique that ensures intrinsic safety and high reliability of the initiator, small-scale bridge foils is a promising energy exchange element for future low energy plasma initiating device. The thermal-electrical performance of small-scale copper bridge foils was simulated using finite element method. Results show that higher temperature acceleration occurs at the corners of the bridge, and then the generated ohmic heat will diffuse all over the bridge. While the energy excitation is identical, the time to melt temperature at the center of the bridge will decrease as the bridge width decreases. Furthermore, when the period of the pulse current remains constant, time to melt temperature will increase as the charge voltage decreases till the bridge cannot reach melt temperature.

Key words: material physics and chemistry; small-scale bridge foil; thermal-electric analysis; finite element method; electroexploding

CLC number: TJ450.1

Document code: A

DOI: 10.3969/j.issn.1006-9941.2013.04.019